

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт сильноточной электроники
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИСЭ СО РАН)

П Р И К А З

17.09.2015г. № 100

г. Томск

О зачислении в аспирантуру и назначении
стипендии

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 и Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сильноточной электроники СО РАН, утвержденными приказом директора института от 28.05.2014 г. № 54, и на основании протокола заседания приемной комиссии № 2 от 15 сентября 2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Батурину Екатерину Вячеславовну с 01 сентября 2015 года зачислить на первый курс очного обучения в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета сроком на 4 года по направлению подготовки 03.06.01 – Физика и астрономия, по направленности (специальности) 01.04.04 – Физическая электроника, и установить Батуриной Е. В. с 01 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года ежемесячную стипендию в размере 8681,66 рублей с учетом р.к.

2. Вагайцева Семёна Александровича с 01 сентября 2015 года зачислить на первый курс очного обучения в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета сроком на 4 года по направлению подготовки 03.06.01 – Физика и астрономия, по направленности (специальности) 01.04.13 – Электрофизика, электрофизические установки, и установить Вагайцеву С. А. с 01 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года ежемесячную стипендию в размере 8681,66 рублей с учетом р.к.

Врио директора института



Н. А. Ратахин

СОГЛАСОВАНО:
Ученый секретарь



И. В. Пегель